

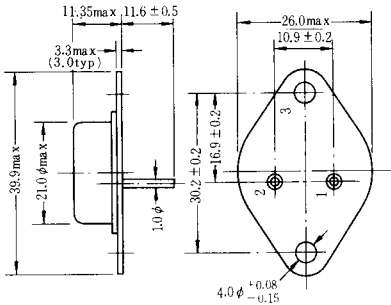
2SD581, 2SD581A

シリコン NPN エピタキシャル形

40~60W オーディオアンプ出力増幅用
2SB611, 611A とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

40~60W AUDIO AMP. POWER OUTPUT
Complementary pair with 2SB611/A



1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

アクセサリ Accessories

スペーサ	Spacer	SK40C
ワッシャ	Washer	YD40D

(JEDEC TO-3)

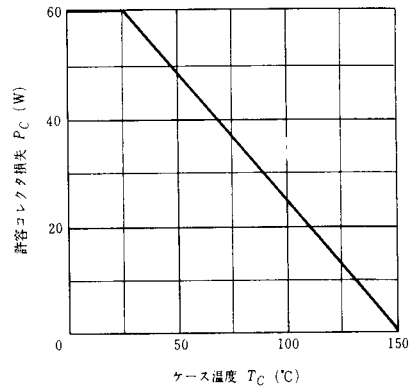
■最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SD581	2SD581A	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	150	150	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	100	120	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	6	V
コレクタ電流	I_C	7	7	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(sat)}$	12	12	A
ベース電流	I_B	2	2	A
許容コレクタ損失	P_C^*	60	60	W
接合部温度	T_j	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION
CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	2SD581			2SD581A			Unit	
			min	typ	max	min	typ	max		
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	100	—	—	120	—	—	V	
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=5\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	6	—	—	V	
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=120\text{V}, I_E=0$	—	—	10	—	—	10	μA	
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=5\text{V}$	$I_C=1\text{A}$		60	—	200	60	—	200
	h_{FE2}		$I_C=5\text{A}$		25	—	—	25	—	—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{A}, I_B=0.5\text{A}$	—	—	1.5	—	—	1.5	V	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	—	—	1.5	—	—	1.5	V	
安全動作領域	ASO	$V_{CB}=70\text{V}, t=1\text{sec}$	1	—	—	1	—	—	A	
2次破壊電流	I_M	$V_{CE}=70\text{V}, 50\text{Hz Half Wave}, 30\text{ Pulses}$	3	—	—	3	—	—	A	

* 2SD581, 581Aは h_{FE1} の値により下記のように2区分し、現品に表示してあります。

* The 2SD581/A is grouped by h_{FE1} as follows.

Ⓑ	Ⓒ
60~120	100~200